BTDA-BBPA 단위구조를 갖는 신규 감광성 폴리아믹산에스테르(PSPAE): 합성, 광패터닝 및 이미드화

 박유진*[#] · 이중헌***[#] · 문유경* · 서영범* · 김윤호*** · 원종찬**** · 김진수****⁶
*한국화학연구원 고기능고분자연구센터, ** 과학기술연합대학원대학교 KRICT스쿨 (2018년 11월 14일 접수, 2018년 12월 13일 수정, 2018년 12월 14일 채택)

New Photosensitive Poly(amic acid ester) with BTDA-BBPA Unit: Synthesis, Photopatterning, and Imidization

Yu Jin Park^{*,#}, Jung Heon Lee^{*,**,#}, Yu Kyoung Moon^{*}, Young Beom Seo^{*}, Yun Ho Kim^{*,**}, Jong Chan Won^{*,**}, and Jinsoo Kim^{*,**†}

*Center for Advanced Funtional Polymers, Korea Reserch Institute of Chemical Technology, Gajeongro 141, Yuseong, Daejeon 34114, Korea **KRICT School, University of Science and Technology (UST), Gajeongro 217, Yuseong, Daejeon 34113, Korea

(Received November 14, 2018; Revised December 13, 2018; Accepted December 14, 2018)

초록: BTDA 산이무수물과 BBPA 디아민을 사용하여 새로운 감광성 폴리아믹산 에스테르인 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)를 합성하였다. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)를 NMP에 녹인 후 TEGDA(가교제), Irgacure 819(광개시제)를 첨가하여 네가티브 감광성 PSPAE 조성물을 제조하였다. PSPAE 조성물을 스펀코팅하여 제조한 PSPAE-F1 필름을 350 °C에서 이미드화하여 폴리이미드 필름(PI-F1)을 얻었다. PSPAE F1과 PI-F1 필름의 TGA 곡선을 기록하고 열적 거동을 조사하였다. PSPAE 필름을 광패터닝 후 이미드화를 실시하여 20-100 µm의 해상도와 20 µm 두께를 갖는 패터닝된 PI 필름을 제조하였다. 또한 이미드화 후 막두께 감소율은 약 25%로 측정되었으며 이는 기존 PSPAE (PMDA-ODA-HEMA) 제품의 막두께 감소율(40-50%)과 비교하여 현저히 향상되었다.

Abstract: The new photosensitive polyamic acid ester, PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA), was synthesized by using BTDA and BBPA as an acid dianhydride and a diamine, respectively. After dissolving PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) in NMP, TEGDA (crosslinker) and Irgacure 819 (photoinitiator) were added to produce a negative photosensitive PSPAE composition. The polyimide film (PI-F1) was prepared by spin coating of the PSPAE composition followed by imidization of PSPAE-F1 at 350 °C. The TGA curves of PSPAE-F1 and PI-F1 films were recorded and the thermal behavior was investigated. The PSPAE film was photopatterned and imidized to produce the patterned PI film having a resolution of 20-100 μ m and a thickness of 20 μ m. In addition, the film reduction rate after imidization was about 25%, which was remarkably improved compared with that (40-50%) of the conventional PSPAE (PMDA-ODA-HEMA) products.

Keywords: photosensitive poly(amic acid ester), synthesis, formulation, photopatterning, film thickness.

서 론

반도체 산업이 발전함에 따라 반도체 검사 장비 산업의 중 요성이 커지고 있다. 반도체 검사 장비 중에서도 probe card 를 포함하는 probe station은 웨이퍼와 주검사 장비를 전기적 으로 연결하는 역할을 하고 웨이퍼 칩의 정상 여부를 검사한 다. 즉 probe card에 있는 probe tip을 웨이퍼의 칩패드(chip pad)에 접촉시키고 주검사 장비로부터 전기적인 신호를 보내 칩의 불량 여부를 판정하는 것이다.¹ Probe card의 성능을 향 상시키기 위하여 기판에 배선층과 절연막을 적층한 다층형 소자를 제작하고 있다. 다층형 소자 제작 시에 배선층간의 전 극을 연결하기 위하여 10-30 μm 두께의 필름 형성 및 직경 약 10-100 μm 정도의 hole과 line의 미세 패턴 형성이 가능 한 절연재료가 요구되고 있다.²

감광성 폴리이미드(PSPIs: photosensitive polyimides)는 우

 [#]These authors contributed equally to this work.
[†]To whom correspondence should be addressed.
jinsoo@krict.re.kr, ORCiD[®] 0000-0002-0035-7267
©2019 The Polymer Society of Korea. All rights reserved.

수한 내열 특성, 화학적 안정성 및 절연 특성때문에 반도체 소자의 층간 절연막 뿐만 아니라 버퍼 및 알파선 차폐층으로 서 사용되고 있다.³⁻⁸ 또한 감광성 폴리이미드 소재를 사용하 면 추가의 포토레지스트가 불필요하고 총 공정수를 대폭 줄 일 수 있기 때문에 반도체 소자의 생산 공정 단축, 원가 절 감 및 품질 향상이 가능하다고 알려져 있다.⁷⁻⁹

감광성 폴리아믹산 에스테르(PSPAE) 기반의 네가티브형 감광성 폴리이미드는 1976년에 Rubner 등에 의해 최초로 개 발되었고 반도체 산업에서 널리 사용되고 있다. PSPAE는 일 반적인 폴리이미드 전구체인 폴리아믹산에 아크릴 감광기가 에스테르 결합을 통해 결합된 형태의 고분자이며 광경화 특 성을 갖는다.¹⁰

일반적으로 광개시제와 광가교제가 첨가된 PSPAE 용액을 실리콘웨이퍼 기판에 코팅 후 건조하여 제작한 필름 상에 UV 를 조사하면 아크릴기의 이중결합간의 가교결합에 의해 광경 화되고 유기용제에 대한 용해도가 획기적으로 감소하게 된 다. 따라서 PSPAE 필름과 광원 사이에 패터닝된 마스크를 놓고 UV를 조사하면 PSPAE 필름에 패턴이 형성된다. 이 필 름을 유기용제로 처리하면 미경화부는 용해되어 제거되고 경 화부만 남아서 마스크와 동일한 패턴 모양을 갖는 PSPAE 필 름을 제작할 수 있다. 이와 같이 패터닝된 PSPAE 필름은 350-400 °C에서 1시간 이상 열처리 공정 과정에서 광경화기가 열 분해로 제거되면서 이미드화되어 패턴을 갖는 폴리이미드(PI) 필름으로 전환된다.⁴

PSPAE 기반의 네가티브형 감광성 폴리이미드 제품들은 높은 기계적 강도, 저유전 특성, 저 coefficient of thermal expansion(CTE)가 보장되고 공정이 용이한 장점이 있으나 40-50%의 높은 필름 두께 감소가 수반되는 문제가 있다.4 필름 두께 감소 현상은 이미드화 과정에서 광경화기의 번아웃에 의해 발생되며 광패턴의 "crowning" 효과를 일으키는 원인으 로 알려져 있다.11,12 본 연구에서는 네가티브형 감광성 폴리 이미드의 필름 두께 감소 문제를 해결하고자 PSPAE를 구성 하는 주사슬 단량체의 분자량을 증가시켜서 열분해되는 광경 화기의 비율을 줄인 새로운 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)를 합성하였고 이를 사용하여 네가티브형 PSPAE 조성물을 제 조하였다. 산이무수물은 BTDA, 디아민은 BBPA를 사용하였 다. 광경화기 열분해 후 무게 감소 및 이미드 필름의 두께 감 소율의 비교 대상으로는 PSPAE(PMDA-ODA-HEMA)를 선 택하였으며 비교실험은 별도로 수행하지 않고 Hiramoto.⁴ Ding 과¹² Nguyen¹³ 등이 보고한 결과를 참고하였다. 본 연구에서 합성된 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 기반의 네가티브형 PSPAE 조성물은 20-100 μm의 해상도와 20~29 μm 두께의 폴리이미드 필름을 제공할 수 있다. 350 °C에서 이미드화 후 의 필름 두께 감소율은 약 25%로서 기존 상용화된 제품의 필름 두께 감소율(40~50%) 대비 현저히 개선된 결과를 보 여주었다.

실 험

재료. 산이무수물 단량체인 benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride(BTDA, Aldrich사)와 디아민 단량체 4,4'bis(4-aminophenoxy)-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl(BBPA, Danyang E-knock chemical사)는 각각 180과 60 °C의 오븐에 서 1일간 건조하여 사용하였다. 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA, Acros Organics사), 1-methyl-2-pyrrolidone(NMP, Junsei사)를 제외한 dichlorophenyl-phosphine oxide(PPD), triethylamine(TEA), tetraethylene glycol diacrylate(TEGDA, 가교제), 2,6-di-*tert*-butyl-4-methylphenol(BHT, 중합방지제), Irgacure 819(광개시제), cyclopentanone(현상액)과 PGMEA (세정액) 등은 Aldrich사에서 구매하여 추가의 정제없이 사용 하였다.

감광성 폴리아믹산 에스테르[PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)] 합성. 기존의 알려진 합성법을¹³ 이용하여 Figure 1 과 같이 두 단계로 합성하였다. 단계 1) BTDA-HEMA 합성 : 질소분위기의 반응기에 BTDA 75.90 g(0.236 mol), BHT 0.304 g, NMP 300 mL를 넣고 교반하면서 HEMA 64.37 g (0.495 mol)을 60분간 적가하였다. 50 mL의 NMP에 희석한 triethylamine(TEA) 52.43 g(0.518 mol)을 상기 용액에 적가한 후 6시간 교반하여 반응을 완결하였다: 단계 2) PSPAE (BTDA-BBPA-HEMA) 합성: 상기 용액에 NMP 900 mL를 추가한 후 5℃까지 냉각한 후, dichlorophenylphosphine oxide(PPD) 91.85 g(0.471 mol)을 30분간 적가하였다. 이 후, 실온으로 승온하고 2시간 추가 교반한 다음 BBPA 100g (0.236 mol)을 반응용액에 천천히 첨가하였다. 실온에서 밤새 교반한 후 여과하여 고형분을 제거하였다. 여액을 2500 mL 의 증류수에 적가하여 얻은 침전을 3회 연속하여 증류수로 수세한 후 50 ℃의 진공오븐에서 24시간 건조하여 219.19g (수율: 78.92%)을 얻었다. Inherent viscosity(30 °C, 0.2 g/dL, NMP). ¹H NMR(DMSO- d_6): δ (ppm) = 10.53(-CONH-); 6.75-8.21(Ar-H); 5.99-5.57(-CH=); 4.50-4.30(-OCH₂CH₂O-); 2.16 (Ar-CH₃); 1.79(-CCH₃=). FTIR: 1710(C=O, ester); 1654(C=O, amide); 1537(C-N, amide), 986(C=C-H, acrylate) cm⁻¹.

BTDA-BBPA-HEMA 기반 네가티브형 PSPAE 포토레지스 트 조성물 제조. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 40 g을 NMP 48.1 g에 녹인 후 tetra(ethylene glycol)diacrylate(TEGDA) 10.44 g, 광개시제(Irgacure 819) 1.46 g을 차례로 첨가하여 교 반하여 균일한 혼합용액을 제조하였다. 혼합용액을 5 μm poly(tetrfluoroethylene) 필터를 통과시켜서 네가티브형 PSPAE 포토레지스트 조성물을 제조하였다.

광패턴 및 열경화. 네가티브 PSPAE 포토레지스트 조성물 을 실리콘 웨이퍼 상에 스핀코팅한 후에 90 °C에서 5분간 열 처리(SOB: soft baking)하여 필름을 형성하였다. 포토마스크 를 필름 위에 위치시킨 후, 고압수은램프(ORIEL 사)를 이용 하여 365 nm 파장의 UV(400 mJ/cm²)를 조사하였다. 노광된 필름을 110 °C에서 3분간 열처리(PEB: post exposure baking) 하고 cyclopentanone으로 360초 현상, PGMEA을 이용하여 비노광부를 제거하는 공정을 차례로 실시하여 뚜렷한 광패턴 을 갖는 필름을 형성하였다. 필름의 패턴 형성성은 광학현미 경(OM)으로 관찰하여 평가하였다. 필름 패턴 시에 최적의 현 상 시간을 결정하기 위하여 필름의 노광부와 비노광부의 두 께변화를 현상액 처리 시간별로 측정하여 용해 속도(dissolution rate)를 조사하였다. 패턴 후 350 °C 진공오븐에서 1시간 열처 리하여 이미드화를 실시하였다.¹¹ SEM을 이용하여 이미드화 전과 후의 두께 변화와 함께 패턴의 표면과 단면의 치수 변 화를 관찰하였다.

기기 및 분석. 합성한 BTDA-HEMA와 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)의 구조는 ¹H NMR(Bruker AMX-400 MHz spectrometer)로 확인하였으며 용매는 dimethylsulfoxide (DMSO-d₆)를 사용하였다. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)의 분자량은 RI 검출기가 부착된 GPC 장비(Waters e2695)를 이 용하고 eluent로서 THF를 사용하였다. 고유점도는 30 ℃에서 automatic viscometer(SCHOTT, ACS350)를 사용하여 측정하 였다. 동점도는 HAAKE VT550를 이용하여 25 ℃에서 측정 하였다. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 및 열경화 후 폴리이 미드의 열특성은 TGA O5000(TA instrument)를 이용하여 질 소 기류(35 mL/min)에서 승온속도 10 ℃/min, 30-800 ℃의 온도범위에서 관찰하였다. 적외선 분광법 장비로는 Smith Chem ID FTIR spectrometer를 사용하여 열경화 후 이미드화 를 확인하였다. MIDAS사의 스핀코팅기를 사용하여 필름을 코팅하였다. 필름의 두께는 Alpha-Step IQ Surface Profiler (KLA-tencor instrument)로 측정하였다. 노광 장비는 MIDAS 사의 MASK Aligner(MDA-400M)를 사용하였다. 패턴 표면 및 단면 모양을 광학현미경(Eclipse 50iPOL, Nikon)과 주사현 미경(Carl Zeiss, SigmaHD)을 이용하여 관찰하였다.

결과 및 토론

PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 합성. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)는 다양한 방법으로⁵⁻¹⁷ 합성이 가능하다. 본 연구에서 는 Nguyen 등이 보고한 합성법을¹³ 참고하여 두 단계로 합성 하였다(Figure 1). 용제는 NMP를 사용하였고 중합을 방지하 기 위하여 소량의 BHT를 첨가하였다. 1당량의 산이무수물 (BTDA)은 2당량의 HEMA와 반응하여 고리가 열리면서 메 타아크릴로일 에스테르와 카복실산기가 각각 2개씩 결합되 어 투명한 BTDA-HEMA 중간체로 전환되었으며 구조는 ¹H NMR로 확인하였다. HEMA의 메타아크릴로일 그룹은 6.09 ppm(-CH=, 2H), 5.71 ppm(-CH=, 2H), 2.19 ppm(-CCH₃=, 6H)에서 나타나고 HEMA의 옥시에톡시기는 4.6-4.4 ppm (-OCH₂CH₂O-, 8H), 고분자 주사슬을 구성하는 BTDA 방향



Figure 1. Synthesis scheme of photocurable polyamic acid ester (PSPAE) of BTDA-BBPA-HEMA.



Figure 2. ¹H NMR spectrum of PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) in DMSO- d_6 .

족 수소는 8.18-7.84 ppm(Ar-H, 6H), 카복실산(Ar-COOH)은 13.72 ppm에서 나타났다. 합성된 BTDA-HEMA 혼합물을 추 가의 분리 또는 정제과정 없이 디아민(BBPA)과 중합반응을 진행하였다. 두 번째 단계에서는 BTDA-HEMA 혼합물 용액 에 PPD를 적가하여 카복실산을 카복실클로라이드로 활성화 시킨 후 디아민(BBPA)을 서서히 첨가하고 중합하여 새로운 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)를 합성하였으며 구조는 ¹H NMR(Figure 2)로 확인하였다. HEMA의 메타아크릴로일 그 룹은 5.99 ppm(-CH=, 2H), 5.57 ppm(-CH=, 2H), 1.79 ppm(-CCH3=, 6H)에서 나타나고 HEMA의 옥시에톡시기는 4.5-4.3 ppm(-OCH₂CH₂O-, 8H), 고분자 주사슬를 구성하는 BTDA과 BBPA의 방향족 수소는 8.21-6.75 ppm(Ar-H, 18H), BBPA의 방향족 메틸 수소는 2.16 ppm(Ar-CH₃, 12H)에서 나 타났다. GPC로 측정한 중량평균 분자량(M_w)과 수평균 분자 량(M_)은 각각 8470, 3921이었으며 다분산지수(PD)는 2.16이 었다.

PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 광경화기 열분해 특성. Hiramoto와⁴ Nguyen의¹³ 보고에 따르면 Figure 3에 보이는 구 조를 갖는 PSPAE(PMDA-ODA-HEMA)는 이미드화 공정 시



Figure 3. Molecular unit structure of PSPAE(PMDA-ODA-HEMA).



Figure 4. TGA curve of PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) with a heating rate of 10 °C/min in nitrogen.

에 36¹³~44%⁴(이론적 중량 감소율: 40%)의 중량이 감소되고 800 ℃ 고온에서 전체 중량의 10% 이하 정도만 잔류한다.

한편, Figure 4는 PSPAE(PMDA-ODA-HEMA)의 주사슬 단량체인 PMDA와 ODA보다 분자량이 큰 BTDA와 BBPA 를 사용하여 합성한 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)의 질소분 위기 하에서 열중량 거동을 고찰한 TGA 곡선이다. 100 ℃ 이하에서 약 0.8%의 중량 감소는 수분에 의한 것이다. 100-370 ℃에서 광경화기의 열분해에 의해 28%의 중량감소가 관 찰되는데 이는 이미드화에 의한 이론적 중량감소율(26%)과 상당히 일치하고 있다. 고분자 주사슬의 열분해는 450 ℃ 이 상에서 일어남을 알 수 있으며 800 ℃의 고온에서도 전체 중 량의 38% 정도는 잔존하는 것을 확인하였다. 즉, 분자량이 큰 단량체를 사용함으로써 광경화기의 열분해에 의한 중량감 소 완화 및 이미드의 내열성 향상이 가능함을 확인하였다.

네가티브 PSPAE 조성물 제조 및 열경화 특성. 신규 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 기반의 네가티브 PSPAE 조성 물을 사용하여 열경화 후에 30 µm의 폴리이미드 후막(PI-F1) 을 제조하였다. 합성한 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 40 g을 NMP 48.1 g에 녹여서 45.4 중량%의 PSPAE 용액을 제조하 였고 동점도는 3025 cPs로 측정되었다. 이 용액에 디아크릴레 이트 단량체인 TEGDA 10.44 g을 추가한 결과 점도는 약 6000 cPs로 두 배 가량 증가하였다. TEGDA는 가교제 기능 뿐만 아니라 조성물의 점도를 높이는 증점제 역할을 하는 것



Figure 5. FTIR spectrum of (a) PSPAE-F1; (b) PI-F1.

을 알 수 있었다. 광개시제로서 1.46 g의 Irgacure 819를 첨가 하였다. 질소분위기 및 상온에서 PSPAE 레진, 아크릴레이트 단량체, 광개시제를 차례대로 NMP에 완전히 녹여서 제조한 네가티브형 PSPAE 조성물의 최종점도는 4600 cPs로 측정되 었다. 이 용액을 스핀코터를 이용하여 실리콘 웨이퍼에 1000 rpm으로 30초간 도포하고 90 ℃에서 5분간 열처리하였 다. 이 후에 광조사 과정은 생략하고 110 ℃에서 3분간 열처 리하여 약 42 µm두께의 두께를 갖는 필름(PSPAE-F1)을 제 조하였다. PSPAE-F1 필름을 350 ℃의 고온진공오븐에서 1시 간 열경화하여 이미드화(PI-F1)하였고 FTIR 스펙트럼을 이용 하여 이미드화 여부를 확인하였다(Figure 5). 즉, Figure 5(b) 에 보이는 바와 같이 열경화된 PI-F1 필름에서 이미드기의 C=O 및 C-N에 해당하는 특징적인 흡수가 각각 1777와 1371 cm⁻¹에서 뚜렷하게 관찰되었다.

열경화된 폴리이미드 필름(PI-F1)의 최종 두께는 30 µm로 확인되었으며 PSPAE-F1 필름 두께(42 µm) 대비 28% 정도 감소하였다. 이는 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 시료의 TGA 곡선(Figure 4)으로부터 예측되었던 28%의 중량 감소값과 일 치하는 값이다. PSPAE를 구성하는 주사슬 단량체의 분자량 증가가 이미드화 후 얻은 PI-F1 필름의 두께 수축률을 감소 시켰으며 기존의 네가티브형 PSPAE의 단점인 필름 두께 감 소 문제를 해결할 수 있었다. PI-F1 필름의 5% 무게 손실 온 도(*T*_{45%})는 470 °C였고, 800 °C에서 필름 시료 잔존량은 60% 로 확인되었다(Figure 6).

용해속도(Dissolution Rate). PSPAE 조성물의 광패턴 공 정 중에 현상액으로 처리하는 시간을 최적화하기 위하여 SOB 후 약 40 μm 두께의 필름 시료 2 종을 제조하였다. UV 조사 를 하지 않은 필름 시료(PSPAE-F2)와 UV(400 mJ/cm²)를 조 사한 필름 시료(PSPAE-F3)를 모두 동일하게 110 °C에서 PEB 를 실시한 후에 현상액으로 처리하여 시간별로 필름두께 변 화(Figure 7)를 관찰하였다. UV 조사를 하지 않은 필름 시료 (PSPAE-F2)는 현상액에 녹아서 30초 후에는 초기 두께의 40%



Figure 6. TGA curve of polyimide film(PI-F1) after imidization with a heating rate of 10 °C/min in nitrogen.



Figure 7. Dissolution rate of PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) in developer: (a) PSPAE-F2; (b) PSPAE-F3.

정도만 남아 있었고 90초 후에는 완전히 제거되었다(Figure 7(a)). UV를 조사한 필름 시료(PSPAE-F3)는 광경화되어 현 상용액에 대해서 450초까지 안정적으로 두께를 유지하였다 (Figure 7(b)). 이 결과를 바탕으로 실제 패턴 공정 시에는 현 상 시간을 360초로 설정하였다.

광패턴. 네가티브 PSPAE 조성물을 이용하여 열경화 후 20 µm 이상의 필름 두께 달성을 목표로 1500 rpm으로 스핀 코팅하고 SOB하여 제조한 필름의 광패턴을 실시하였다. 100, 60, 40, 20 µm의 선폭을 갖는 line과 dot 모양의 패턴을 형성 할 수 있는 포토마스크를 통하여 400 mJ/cm² 의 UV를 조사 한 후, 110 °C에서 3분간 열처리(PEB)를 차례로 진행하였다. Cyclopentanone에서 360초 현상하고 PGMEA로 세정한 후 건조된 필름을 광학현미경으로 관찰하였다. 60 µm 선폭의 line 패턴(Figure 8(a))과 60 µm의 지름을 갖는 dot 패턴(Figure 8(b))을 성공적으로 제작할 수 있었다. 그 이하의 선폭과 지 름을 가지는 패턴의 경우에는 현상과 세정 후에도 미경화부 가 완전히 제거되지 않고 남아있었다. 이 문제는 공정 최적

Figure 8. OM photographs of micropatterned PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) with the resolution of 60 μ m: (a) line pattern; (b) dot pattern.

Figure 9. SEM photographs of micropattern of PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) with the resolution of 60 μ m: (a) before imidization; (b) after imidization.

화를 통해 해결이 가능할 것이다.

PSPAE 조성물; 패턴 및 경화 후 수축율, SEM. Figure 9 의 SEM 사진 중 Figure 9(a)는 Figure 8(b)의 dot 패턴(열경 화 전)을 관찰한 것이고 Figure 9(b)는 Figure 8(b)의 dot 패 턴을 350 ℃ 진공오븐에서 1시간 열경화시킨 후에 얻은 PI dot 패턴을 관찰한 것이다. 열경화 전에 패턴의 두께는 약 27 µm로 측정되었고 열경화 후에는 패턴의 두께가 약 20 µm 로 줄어들었다. 두께 수축률은 약 25%였다. 이 수축률(25%) 은 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)의 TGA 곡선에서 관찰한 중량 감소값(28%)과 패턴형성 전의 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 필름을 연속해서 열경화한 후에 관찰한 두께 감소율 (28%)과 유사한 값이다. 본 연구에서 개발한 네가티브형 PSPAE 조성물은 이미드화 공정 후에 기존 제품보다 필름 두 께 감소율이 낮아서 300 ℃ 이상의 고온 공정을 견디며 높은 두께의 패턴이 요구되는 적층형 소자의 절연층으로 사용하기 에 적합하다.

결 론

BTDA 산이무수물과 BBPA 디아민을 사용하여 새로운 감 광성 PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA)를 합성하였다. 가교제 (TEGDA)와 광개시제(Irgacure 819)를 첨가하여 네가티브 광 경화형 PSPAE 조성물을 제조하고 필름화하였다. 광패턴화 공정을 통해 20-100 µm의 해상도를 가지는 line과 dot 패턴 을 성공적으로 제작할 수 있었다. PSPAE(BTDA-BBPA-HEMA) 필름은 350 ℃에서 열처리를 하여 폴리이미드(BTDA- BBPA) 필름으로 100% 전환시켰다. 이때 발생하는 두께 수 축률은 약 25% 수준으로서 상용화된 PSPAE 제품보다 뚜렷 하게 개선되었다. 최종적으로 20 μm 이상의 두께를 가지는 패턴을 형성할 수 있었으며, 이는 다양한 적층형 반도체 소 자의 고내열 절연층으로 적용 가능함을 보여주고 있다.

감사의 글: 본 연구는 중소기업청 WC300프로젝트(IJ18-01P) 및 한국화학연구원 정부출연 일반사업(SI1803-02) 지원 으로 수행되었으므로 이에 사의를 표합니다.

참 고 문 헌

- F. Wang, R. Cheng, and X. Li, J. Microelectromech. Syst., 18, 933 (2009).
- J. G. Park, H. D. Jeong, C. Noh, and M. Jung, *Polym. Sci. Technol.*, **12**, 642 (2001).
- 3. M. K. Ghosh and K. L. Mittal, *Polyimides-Fundamentals and Applications*, Marcel Dekker, New York, 1996.
- K. Horie and T. Yamashita, *Photosensitive Polyimides-*Fundamentals and Applications, Technomic, Lancaster, PA, 1995.

- T. Masao, O. Ryoji, and P. Hiroyuki, J. Photopolym. Sci. Technol., 28, 73 (2015).
- M. Amane and U. Mitsuru, J. Photopolym. Sci. Technol., 14, 677 (2001).
- 7. S. L. C. Hsu and M. H. Fan, Polymer, 45, 1101 (2004).
- 8. K. Yoshinaga and M. Nomura, Sci. Trend., 23, April (2010).
- 9. F. Kenichi and U. Mitsuru, Polym. J., 40, 281 (2008).
- R. Rubner, H. Ahne, E. Kuhn, and G. Koloddieg, *Photogr. Sci.* Eng., 23, 303 (1979).
- H. Ahne, R. Leuschner, and R. Rubner, *Polym. Adv. Technol.*, 4, 217 (1992).
- 12. H. Hou, J. Jiang, and M. Ding, Eur. Polym. J., 35, 993 (1999).
- L. T. T. Nguyen, H. N. Nguyen, and T. H. T. La, *Opt. Mat.*, 29, 610 (2007).
- 14. R. Rubner, B. Barter, and G. Bald, *Siemens Forsch. Entwickl. Ber.*, **5**, 235 (1976).
- T. Omote, T. Yanaoka, and K. Koseki, J. Appl. Polym. Sci., 38, 389 (1989).
- P. Zhu, Z. Li, W. Feng, Q. Wang, and L. Wang, J. Appl. Polym. Sci., 55, 1111 (1995).
- P. Zhu, Z. Li, W. Feng, Q. Wang, and L. Wang, J. Appl. Polym. Sci., 64, 463 (1997).